

## Laborprotokoll

## **Fachlabor Mikromechatronik**

angefertigt von

Viviane Bremer, Justus Drögemüller, Manisch Kumar Matr.-Nr.: 4254652, 4427984, 1234567

am

Institut für Mikrotechnik Technische Universität Braunschweig

## Inhaltsverzeichnis

1	Introduction		1
	1.1 1.2	Zielsetzung und Gliederung	1 1
2	Prel 2.1 2.2 2.3	liminary Design  Wert und Einheit	2 2 2 2
3	<b>FEN</b> 3.1 3.2	<b>A-Simulation</b> Einfluss der Membrandicke auf die maximale Spannung (Viviane Bremer) Einfluss der Membranabmessungen auf den Spannungsverlauf	3 3 3
4	Etcl	hing Process	5
<b>5 6</b>	5.1 5.2 5.3	Wert und Einheit	7 7 7 7 9
	6.2 6.3	Überschrift	9
7	7.1 7.2 7.3	Wert und Einheit        Überschrift        including pictures	11 11 11 11
8	Zus	ammenfassung und Ausblick	13
Lit	terati	urverzeichnis	14
ар		Erster Anhang	

## 1 Introduction

Hier stehen einig einführende Worte in das Thema der Arbeit.

## 1.1 Zielsetzung und Gliederung

Was ist Sinn und Zweck der Arbeit, wie ist sie aufgebaut und welche Themen werden behandelt [Ost01b].

## 1.2 Geschichte/Literatur

Optionale Betrachtung der Thematik wie sie in der Geschichte und/oder Literatur Erwähnung findet. Hier sollten auch schon der eine [Ost01a] oder andere [Ost02] Literaturverweise auftauchen.

## 2 Preliminary Design

#### 2.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem "Tag"  $\mbox{\tt unit[]{}}$  beziehungsweise  $\mbox{\tt unitfrac[]{}}$ . Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

#### 2.2 Überschrift

# 2.3 Anforderungen an einen Drucksensor (Viviane Bremer)

Für die Auswertung des morphologischen Kastens muss zunächst eine Anforderungsliste erstellt werden. Es soll ein Drucksensor zur Überwachung des Gasdrucks in einer Niederdruck-Pneumatikleitung entwickelt werden. Dieser Druck liegt gewöhnlich zwischen 0 und 1 bar, kann jedoch auf maximal 1,2 bar ansteigen. Die Messgenauigkeit sollte hierbei mindestens bei  $\pm 50$  bar liegen. Eine Änderung des Druckes verläuft sehr langsam und kann somit als quasi-statisch angesehen werden. Da der Sensor in eine bestehendes Gehäuse integriert wird, dürfen seine Abmaße 10x10 mm nicht überschreiten. Das Ausgangssignal soll einer Ausgangsspannung von 0 bis  $1\,\mathrm{V}$  entsprechen und somit den anliegenden Druck in bar repräsentieren. Zur Spannungsversorgen steht eine symmetrische Spannung von  $12\,\mathrm{V}$  und eine Referenzspannung von  $1\,\mathrm{V}$  zur Verfügung. Des Weiteren wird mit einem Bedarf von  $2.000.000\,\mathrm{S}$ tück gerechnet. Die Fertigungskosten sollten bezogen auf die Stückzahl so gering wie möglich ausfallen.

Diese Anforderungen sind nach Fest-, Mindest- und Wunschanforderung in Tabelle blubb aufgelistet.

#### ->morphologischen Kasten bewerten

## 3 FEM-Simulation

## 3.1 Einfluss der Membrandicke auf die maximale Spannung (Viviane Bremer)

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Membrandicke auf die auftretende mechanische Spannung in der Membran betrachtet. Hierfür werden folgende Dicken genutzt:  $15\,\mu\mathrm{m},\ 25\,\mu\mathrm{m},\ 35\,\mu\mathrm{m}.$ 

Zur Analyse wird der anliegende Druck für alle drei Membrandicken in 0.2 bar Schritten von 0.2 bar bis 1 bar erhöht und die resultierende mechanische Spannung ermittelt. Die Verläufe sind in Abbildung **blubb** dargestellt. Die Bruchspannung  $\sigma_{Br}$  von Silizium beträgt 830 MPa und sollte während des Sensorbetriebs nicht überschritten werden. Zur besseren Visualisierung ist sie als Konstante im Graphen dargestellt.

Membran a erreicht die Bruchspannung schon bei einem Druck von 0.439 bar, welcher im benötigten Messbereich liegt. Im Falle von Membran b wird sie knapp oberhalb des Messbereichs bei 1.05 bar erreicht. Die Bruchspannung bei Membran c entspricht einem anliegenden Druck von 2 bar, welcher deutlich oberhalb des Messbereiches ist. Hieraus lassen sich Erkenntnisse für das Sensorverhalten gewinnen. Membran a ist zu dünn für diese Messaufgabe, da sie innerhalb des Messbereichs reißt. Jedoch ist Membran c auch nicht akzeptabel, da niedrige Spannungen auftreten im Vergleich zu Membran b. Diese bildet einen guten Kompromiss für die gewünschte Aufgabe.

## 3.2 Einfluss der Membranabmessungen auf den Spannungsverlauf

#### 3.2.1 Einfluss der Bossgröße (Viviane Bremer)

Zur Analyse des Einflusses der Bossgröße wird die Membrangröße auf 3600  $\mu$ m und die Membrandicke auf 25  $\mu$ m gesetzt. Die Bossgröße wird folgendermaßen variiert: 800  $\mu$ m, 1000  $\mu$ m, 1200  $\mu$ m.

Die Spannungsverläufe und Verschiebungen sind in Abbildung **blubb** dargestellt. Bei einer Bossgröße von  $800 \,\mu\text{m}$  treten Spannungen von bis zu  $274 \,\text{MPa}$  auf. Eine Vergrößerung des Bosses auf  $1000 \,\mu\text{m}$  führt zu einer maximalen Spannung von  $178 \,\text{MPa}$ . Der größte Boss senkt die auftretende Spannung auf  $128 \,\text{MPa}$ . Des Weiteren ist zu sehen,

dass eine Vergrößerung des Bosses zu einer Angleichung der Spannungsspitzen führt und die Dehnung der Membran von 374  $\mu m$ auf 77  $\mu m$ senkt.

## 4 Etching Process

(Viviane Bremer)

Für die Erstellung der Sensormembran muss zunächst der Ätzprozess charakterisiert werden. Zur Berechnung des zu ätzenden Volumens wird folgende Volumenformel eines Pyramidenstumpfes,

$$V = \frac{h}{3}(A_1 + \sqrt{A_1 A_2} + A_2), \tag{4.1}$$

benötigt. Für die Fertigung wird ein 4Wafer mit einer Dicke von  $450\,\mu m$  genutzt. Die zu erzeugende Membran ohne Boss hat eine Breite von  $4000\,\mu m$  und eine Dicke von  $25\,\mu m$ . Dies führt zu einer Ätzhöhe von

$$h = 450 \,\mu m - 25 \,\mu m = 425 \,\mu m. \tag{4.2}$$

Die Fläche  $A_1$  bestimmt sich mit der Membranbreite zu

$$A_1 = a_1^2 = 4000 \,\mu m \cdot 4000 \,\mu m = 16 \,mm^2. \tag{4.3}$$

Fläche  $A_2$  ergibt sich mit

$$\tan(54,7^{\circ}) = \frac{425\,\mu m}{\Delta a} \tag{4.4}$$

$$\Delta a = \frac{425 \,\mu m}{\tan(54,7^{\circ})} = 300 \,\mu m \tag{4.5}$$

$$a_2 = a_1 - 2\Delta a = 3400\,\mu m\tag{4.6}$$

zu

$$A_2 = a_2^2 = 11,56 \, mm^2. \tag{4.7}$$

Dies eingesetzt in Gleichung 4.1 ergibt für das zu ätzende Volumen

$$V_{Si} = \frac{0.425 \, mm}{3} (16 + \sqrt{16 \cdot 11.56} + 11.56) \, mm^2 = 5.831 \, mm^3. \tag{4.8}$$

Die Dichte  $\rho_{Si}$  von Silizium beträgt  $0.002336\,\mathrm{g/mm^3}$ . Dies führt mit dem errechneten Volumen zu einer Masse von

$$m_{Si} = \rho V_{Si} = 0.0137 g \tag{4.9}$$

Mit der Molmasse von Silizium,  $M_{Si}$  =28.09 g/mol, ergibt sich die Stoffmenge zu

$$n_{Si} = \frac{m_{Si}}{M_{Si}} = 4.877 \cdot 10^{-4}. (4.10)$$

## 5 Characterising

#### 5.1 Allgemeines

Nachdem am ersten Labortag der Sensor mit Hilfe von SolidWorks designt und auf theoretischer Grundlage mit verschiedenen Simulationen berechnet wurde, musste am darauffolgenden Labortag eine Charakterisierung erfolgen. Aufgrund von Fertigungsabweichungen, die nie vermieden werden können, verhalten sich Sensoren immer unterschiedlich. Dies spiegelt sich unter Anderem in der Sensitivität, dem Offset oder auch in der Messgenauigkeit wider. Um den Abweichungen entgegenzuwirken, müssen bestimmte Eigenschaften des entsprechenden Sensors also zunächst ermittelt werden. Das IMT stellte jedem Laborteilnehmer einen vorgefertigten Sensor zur Verfügung, der dem erstellten Design vom vorherigen Labortag entsprach. Lediglich bei der Betrachtung unter dem Mikroskop ließen sich Differenzen feststellen. Der Unterschied zwischen den Drucksensoren ergab sich aus der Anordnung der jeweiligen Resistoren, die stellenweise in die Sensormembran eingearbeitet sind und der piezoresistiven Spannungsmessung dienen. Abbildung XX zeigt eine t-förmige Anordnung der Resistoren, Abbildung YX und YY eine longitudinale. Eine Festlegung, welche Anordnung für die gegebenen Anforderungen am besten geeignet sei, erfolgte durch Überlegung. Anschließend begann die eigentliche Charakterisierung in Form eines Versuchs.

#### 5.2 Versuchsaufbau und -durchführung

#### 5.3 Auswertung

Die gemessenen Werte wurden anschließend mit Hilfe von Microsoft Excel ausgewertet.

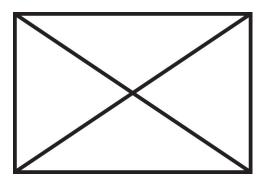


Abbildung 5.1: Einzelne Abbildung

## 6 Circuit Layout

#### 6.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem "Tag"  $\mbox{\tt unit[]{}}$  beziehungsweise  $\mbox{\tt unitfrac[]{}}$ . Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

#### 6.2 Überschrift

#### 6.3 Abbildungen einbinden

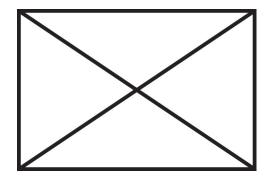


Abbildung 6.1: Einzelne Abbildung

```
Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text
```

## 7 Evaluation Circuit

#### 7.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem "Tag"  $\mbox{\tt unit[]{}}$  beziehungsweise  $\mbox{\tt unitfrac[]{}}$ . Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

#### 7.2 Überschrift

#### 7.3 including pictures

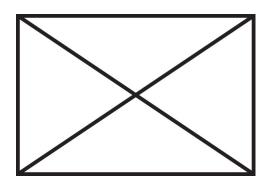


Abbildung 7.1: Einzelne Abbildung

```
Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text
```

# 8 Zusammenfassung und Ausblick

Hier stehen die Ergebnisse der Arbeit und ein kurzer Ausblick wie es weiter gehen kann.

## Literaturverzeichnis

- [Ost01a] OSTERMEYER, G.-P.: Schriften zur Mechanik. Bd. 1: Mechanik I Grundlagen, Statik starrer Körper, Statik elastischer Körper. Braunschweig: TU Braunschweig, 2001. ISBN 3-936148-01-5
- [Ost01b] OSTERMEYER, G.-P.: Schriften zur Mechanik. Bd. 5: Mechanik III Kontinuumsschwingungen, Prinzipien der Mechanik, Hydromechanik. Braunschweig: TU Braunschweig, 2001. ISBN 3-936148-05-8
- [Ost02] OSTERMEYER, G.-P.: Schriften zur Mechanik. Bd. 2: Mechanik II Stabilität, Kinematik und Kinetik, Schwingungen, Stoß. Braunschweig: TU Braunschweig, 2002. ISBN 3-936148-02-3

# **Appendix**

## A.1 Erster Anhang

Ein Anhang.

## A.2 Zweiter Anhang

Ein weiterer Anhang.